

型名	社名	用途	構造	封 装 形 式	最大定格					電氣的特性 (Ta=25°C)														
					V*** (V)	区分***	VGS* (V)	区分*	I* (A)	区分*	Pd/Pch (W)	I <sub>GSS</sub> (max) (A)	V <sub>GS</sub> (V)	I <sub>PSS</sub> (min) (A)	I <sub>PSS</sub> (max) (A)	V <sub>DS</sub> (V)	V <sub>GS(off)</sub> (min) (V)	V <sub>GS(off)</sub> (max) (V)	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (A)	I <sub>D</sub> (A)	I <sub>D</sub> (A)	I <sub>D</sub> (A)	
PF0015	日立	824~849MHz PA	MOS		12	DD			2	D														
PF0016	日立	890~915MHz PA	MOS		12	DD			2	D														
PF0017	日立	872~905MHz PA	MOS		12	DD			2	D														
PF0020	日立	820~850MHz PA	MOS		17	DD			3	D														
PF0022	日立	872~905MHz PA	MOS		17	DD			3	D														
PM1210B	日立	HS PSW	MOS	N E	120	DSS	±20	S	10	D	50	±1μ	±20	1m	100	1	4.5	10	1m	1.5	2	10	5	
PM1220B	日立	HS PSW	MOS	N E	120	DSS	±20	S	20	D	80	±1μ	±20	1m	100	1	4.5	10	1m	2.5	4	10	10	
PM4550C	日立	HS PSW	MOS	N E	450	DSS	±20	S	50	D	300	±1μ	±20	1m	360	2	4	10	1m	8	12	10	25	
PM4550J	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±30	S	50/CH	D	300/CH	±10μ	±25	500μ	360	2	3	10	1m	18	30	10	25	
PM4550N	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±30	S	50/CH	D	300/CH	±10μ	±25	500μ	360	2	3	10	1m	18	30	10	25	
PM4575J	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±30	S	75/CH	D	350/CH	±10μ	±25	500μ	360	2	3	10	1m	18	30	10	25	
PM4575N	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±30	S	75/CH	D	350/CH	±10μ	±25	500μ	360	2	3	10	1m	25	45	10	30	
PM5050J	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	500	DSS	±30	S	50/CH	D	300/CH	±10μ	±25	500μ	400	2	3	10	1m	18	30	10	25	
PM5050N	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	500	DSS	±30	S	50/CH	D	300/CH	±10μ	±25	500μ	400	2	3	10	1m	18	30	10	25	
PM5075J	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	500	DSS	±30	S	75/CH	D	350/CH	±10μ	±25	500μ	400	2	3	10	1m	18	30	10	25	
PM5075N	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	500	DSS	±30	S	75/CH	D	350/CH	±10μ	±25	500μ	400	2	3	10	1m	25	45	10	30	
PM45100K	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±30	S	100/CH	D	400/CH	±10μ	±25	1m	360	2	3	10	1m		55	10	50	
PM45150K	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±30	S	150/CH	D	500/CH	±10μ	±25	1m	360	2	3	10	1m		80	10	75	
PM45302F	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±20	S	30/CH	D	200/CH	±50μ	±16	1m	360	1.5	4	10	1m	15	25	10	15	
PM45502C	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±20	S	50/CH	D	300/CH	±50μ	±16	1m	360	1.5	4	10	1m	25	40	10	25	
PMS0100K	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	450	DSS	±30	S	100/CH	D	400/CH	±20μ	±25	1m	400	2	3	10	1m	30	55	10	25	
PM50150K	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	500	DSS	±30	S	150/CH	D	450/CH	±20μ	±25	1m	400	2	3	10	1m	45	80	10	25	
PM50302F	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	500	DSS	±20	S	30/CH	D	200/CH	±50μ	±16	1m	400	1.5	4	10	1m	15	25	10	15	
PM50502C	日立	ε-μ制御, SW-Reg	MOS	N E	500	DSS	±20	S	50/CH	D	300/CH	±50μ	±16	1m	400	1.5	4	10	1m	25	40	10	25	
PU61C56	松下	Motor/Relay-D, SW	MOS	N E	37±7	DSS	±20	S	6	D	15	±10μ	±20	10μ	25	1.2	2.5	10	1m	2.5	4	10	3	
PU7456	松下	Motor/Relay-D	MOS	N E	35±10	DSS	±20	S	6	D	15	±1μ	±20	10μ	20	1	2.5	25	1m	3	5.5	25	3	
PU8432	松下	Motor/Relay-D, SW	MOS	N E	150	DSS	±20	S	3	D	15	±1μ	±20	10μ	120	1	2.5	10	1m	3	5.3	10	3	
PU8456	松下	Motor/Relay-D, SW	MOS	N E	35±10	DSS	±20	S	6	D	15	±1μ	±20	10μ	20	1	2.5	25	1m	3	5.5	25	3	
RHF1203CL	ロム	X-Band LN A	InGaAs	N D	4	DSX	-2.5	O	60m	D	200m			12m	60m	2	-0.2	-2	2	1m	30m	45m	2	10m
SGH5002E	ルネサ	MW LN A	GaAsHEMT	N D	5	DS	-3.5	O	70m	D	340m	-100μ	-3	10m	70m	2	-0.2	-3	2	500μ	25m	40m	2	10m

電 気 的 特 性 (Ta=25℃)											コンプリ メンタリ	外 形	備 考	型 名	
Cis (typ) (pF)	Crs (typ) (pF)	Vgs (V)	Vds (V)	NF typ dB	NF max dB	f (Hz)	R <sub>G</sub> (Ω)	R <sub>DS(ON)</sub> (max) (Ω)	V <sub>GS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (A)					その他特性
											Pout=1.2Wtyp	f=824~849MHz, Pin=1mW	300	電力増幅器	PF0015
											Pout=2Wtyp	f=890~915MHz, Pin=1mW	300	電力増幅器	PF0016
											Pout=1.2Wtyp	f=872~905MHz, Pin=1mW	300	電力増幅器	PF0017
											Pout=6Wtyp	f=820~850MHz, Pin=2mW	299	電力増幅器	PF0020
											Pout=6Wtyp	f=872~905MHz, Pin=2mW	299	電力増幅器	PF0022
1130	80	0	10					0.3	15	5			133		PM1210B
2200	200	0	10					0.15	15	10			133		PM1220B
7500	175	0	10					0.18	15	25			36		PM4550C
5800	170	0	10					0.19	10	50	ton=485ns, toff=740nstyp	ID=25A	301	2SK × 2	PM4550J
5800	170	0	10					0.18	10	50	ton=485ns, toff=740nstyp	ID=25A	302	2SK × 2	PM4550N
8700	235	0	10					0.16	10	75	ton=660ns, toff=1060nstyp	ID=30A	301	2SK × 2	PM4575J
8700	235	0	10					0.12	10	30	ton=660ns, toff=1060nstyp	ID=30A	302	2SK × 2	PM4575N
5800	170	0	10					0.19	10	50	ton=485ns, toff=740nstyp	ID=25A	301	2SK × 2	PM5050J
5800	170	0	10					0.18	10	50	ton=485ns, toff=740nstyp	ID=25A	302	2SK × 2	PM5050N
8700	235	0	10					0.16	10	75	ton=660ns, toff=1060nstyp	ID=30A	301	2SK × 2	PM5075J
8700	235	0	10					0.12	10	30	ton=660ns, toff=1060nstyp	ID=30A	302	2SK × 2	PM5075N
14600	650	0	10					0.1	10	50	ton=90ns, toff=1020nstyp	ID=50A, VGS=10V	303	2SK × 2, 暫定	PM45100K
22600	580	0	10					0.08	10	75	ton=1020ns, toff=1590ns	ID=75A, VGS=10V	303	2SK × 2, 暫定	PM45150K
6150	240	0	10					0.2	10	15	ton=580ns, toff=900nstyp	ID=15A	237	2SK × 2	PM45302F
10250	400	0	10					0.12	10	25	ton=850ns, toff=1400nstyp	ID=25A	36	2SK × 2	PM45502C
11600	340	0	10					0.1	10	100	ton=800ns, toff=1600nstyp	ID=25A	303	2SK × 2	PM50100K
17400	470	0	10					0.08	10	150	ton=1μs, toff=1.9μstyp	ID=30A	303	2SK × 2	PM50150K
6150	240	0	10					0.2	10	15	ton=580ns, toff=900nstyp	ID=15A	237	2SK × 2	PM50302F
10250	400	0	10					0.12	10	25	ton=850ns, toff=1400nstyp	ID=25A	36	2SK × 2	PM50502C
40	20	0	10					0.14	10	3	ton=1μs, tf=2μstyp	ID=3A, VDD=30V	350	2SK × 3	PU61C56
40	20	0	10					0.14	10	3	ton=1μs, tf=2μstyp	ID=3A, VDD=30V	313		PU7456
670	63	0	10					0.6	10	3	ton=30ns, tf=50nstyp	ID=3A, VDD=100V	351	2SK × 4	PU8432
40	20	0	10					0.14	10	3	ton=1μs, tf=2μstyp	ID=3A, VDD=30V	351	2SK × 4	PU8456
				.85	1.1	12G					Ga=9dBmin/10.5dBtyp	f=12GHz	266		RHP1203CL
				1.7	12G						Ga=8.5dBmin	f=12GHz	339	GSDS	SGH5002E